9013 NPN SILICON TRANSISTOR

TO—92

1.EMITTER
发 射 极
2.BASE
基 极
3.COLLECTOR
集 电 极

1 2 3

FEATURES

特 征

Power dissipation （最大耗散功率）

P_{CM} : 0.625 W（Tamb=25℃）

Collector current （最大集电极电流）

I_{CM} : 0.5 A

Collector-base voltage （集电极--基极击穿电压）

$V_{(BR)CBO}$: 45 V

ELECTRICAL CHARACTERISTICS（Tamb=25℃ unless otherwise specified）

电 特 性 （环境温度 除 非 另 有 规 定）

Parameter 参 数	Symbol 符 号	Test conditions 测 试 条 件	MIN 最小值	TYP 典型值	MAX 最大值	UNIT 单位
Collector-base breakdown voltage 集 电 极 - - 基 极 击 穿 电 压	$V(BR)_{CBO}$	Ic= 100 μ A， I_E=0	45			V
Collector-emitter breakdown voltage 集 电 极 - - 发 射 极 击 穿 电 压	$V(BR)_{CEO}$	Ic= 0. 1 mA， I_B=0	25			V
Emitter-base breakdown voltage 发 射 极 - - 基 极 击 穿 电 压	$V(BR)_{EBO}$	I_E= 100 μ A， I_C=0	5			V
Collector cut-off current 集 电 极 - - 基 极 截 止 电 流	I_{CBO}	V_{CB}= 40 V I_E=0			0.1	μ A
Collector cut-off current 集电极 - - 发射极截止电流	I_{CEO}	V_{CE}= 20 V I_B=0			0.1	μ A
Emitter cut-off current 发射极 - - 基极截止电流	I_{EBO}	V_{EB}= 5 V， I_C=0			0.1	μ A
DC current gain(note) 直 流 电 流 增 益	$H_{FE\ (1)}$	V_{CE}= 1 V, I_C= 50 mA	64		300	
	$H_{FE\ (2)}$	V_{CE}= 1V, I_C =500 mA	40			
Collector-emitter saturation voltage 集 电 极 - - 发 射 极 饱 和 压 降	V_{CE}(sat)	I_C= 500 mA, I_B=50 mA			0.6	V
Base-emitter saturation voltage 基极--发射极饱和压降	V_{BE}(sat)	I_C= 500mA, I_B= 50 mA			1.2	V
Base-emitter voltage 基极--发射极正向电压	V_{BE}	I_E=100mA			1.4	V
Transition frequency 特 征 频 率	f_T	V_{CE}= 6 V, I_C= 20 mA f =30MHz	150			MHz

CLASSIFICATION OF $H_{FE(1)}$ （分类）

Rank 档次	D	E	F	G	H	I
Range 范围	64-91	78-112	96-135	112-166	144-220	190-300

Wing Shing Computer Components Co., (H.K.)Ltd. Tel:(852)2341 9276 Fax:(852)2797 8153
Homepage: http://www.wingshing.com E-mail: wsccltd@hkstar.com

littlediode
COMPONENTS FOR ALL

Littlediode supplies new, hard to find or obsolete electronic components and semiconductors all over the world.

With over two million different components listed you are sure to find the part you need.

Feel free to visit us today at our online store:

LittleDiode.com

Looking forward to providing you with the best possible service.